

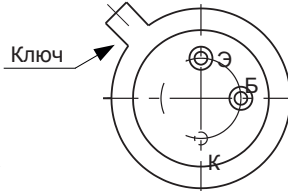
# ДП КВАЗАР-ИС

## ЭТИКЕТКА

Транзисторы:  
2Т836А, 2Т836Б.

Кремневые планарные р-п-р транзисторы 2Т836А, 2Т836Б в металлостеклянном корпусе предназначены для работы в ключевых усилителях мощности, вторичных источниках питания и других схемах.

Схемы расположения выводов



Масса не более 1,4 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 °С

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма			
		2Т836А		2Т836Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ( $U_{кб} = 5 В, I_{э} = 2 А$ )	$h_{21Э}$	20	-	20	-
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В ( $R_{бэ} \leq 100 Ом$ )	$U_{кэ max}$	90	-	85	-
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{кб max}$	90	-	85	-
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{эб max}$	5	-	5	-
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{к max}$	-	3	-	3
Обратный ток коллектора, мА ( $U_{кб} = 90 В$ для 2Т836А, $U_{кб} = 85 В$ для 2Т836Б)	$I_{кб0}$	-	0,1	-	0,1
Обратный ток эмиттера, мА ( $U_{эб} = 5 В$ )	$I_{эб0}$	-	1	-	1
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_{к} = 2 А, I_{б} = 0,2 А$ для 2Т836А; $I_{б} = 0,08 А$ для 2Т836Б)	$U_{кэнас}$	-	0,6	-	0,35
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_{к} = 2 А, I_{б} = 0,2 А$ для 2Т836А; $I_{б} = 0,08 А$ для 2Т836Б)	$U_{бэнас}$	-	1,3	-	1,2
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, МГц	$f_{гр}$	4	40	4	40

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 штук транзисторов

Содержание золота \_\_\_\_\_ г

Цветных металлов не содержится

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т836А, 2Т836Б соответствуют техническим условиям аА0.339.164 ТУ.

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ дата

Место для  
штампа ОТК

Место для штампа  
военного  
представительства

Место для штампа "Пере проверка произведена \_\_\_\_\_" дата

Место для  
штампа ОТК

Место для штампа  
военного  
представительства